

출력 일자: 2004/10/12

발송번호 : 9-5-2004-040809898
발송일자 : 2004.09.24
제출기일 : 2004.11.24

수신 : 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국
제특허법률사무소)
임창현 귀하

135-080

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 삼성전자주식회사 (출원인코드: 119981042713)

주소 경기도 수원시 영통구 매탄동 416

대리인 성명 임창현 외 1 명

주소 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국제특허법률사무소)

출원번호 10-2002-0081790

발명의 명칭 플로팅 게이트를 갖는 비휘발성 기억 셀 및 그 형성방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제 25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-19항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 청구항 제1-8항의 플로팅 게이트의 측벽은 제1 도전막 패턴 및 제2 도전막 패턴 중 하나가 돌출되어 요철형태를 이루는 비휘발성 기억 셀은 인용발명1(한국공개특허공보 1997-18737호 (1997.04.30))의 플로팅 게이트의 측벽이 요철형태를 이루는 플래쉬 이이피롬 셀 및 인용발명2(일본공개특허공보 평03-34577호(1991.02.14))의 플로팅 게이트의 측벽이 요철형태를 이루는 비휘발성 반도체 기억장치 등에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

2. 청구항 제9-19항의 요철형태의 플로팅 게이트의 측벽을 형성하는 단계를 갖는 비휘발성 기억 셀 제조방법은 인용발명1의 플로팅 게이트의 측벽을 요철형태로 형성하는 단계를 갖는 플래쉬 이이피롬 셀 제조방법 및 인용발명2의 요철형태의 플로팅 게이트의 측벽을 형성하는 단계를 갖는 비휘발성 반도체 기억장치 제조방법 등에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

[첨부]

첨부 1 공개특허 제1997-18737호(1997.04.30) 1부.

첨부2 일본공개특허공보 평03-034577호(1991.02.14) 1부. 끝.

2004.09.24

특허청

전기전자심사국

응용소자심사담당관실

심사관 김근모



출력 일자: 2004/10/12

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5985 로 문의하시기 바랍니다.
서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터 ☎1544-8080으로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.
▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터